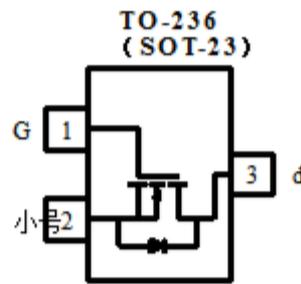




### N沟道100-V (DS) MOSFET

产品摘要		
V <sub>DS</sub> (V)	DS (上) (W)	我 D (A)
100	0.250 @ V <sub>GS</sub> = 10V	1.5

特征  
D 100% R<sub>g</sub> 测试



顶视图  
Si2328DS (D8) \*  
\*标记代码

订购信息: Si2328DS-T1  
Si2328DS-T1-E3 (Lead (Pb) -Free)

绝对最大额定值 (T <sub>A</sub> = 25°C, 除非另有说明)					
参数	符号	5秒	稳定状态	单元	
漏源电压	V <sub>DS</sub>	100		V	
门源电压	V <sub>GS</sub>	“20			
漏极连续电流 (T <sub>J</sub> = 150°C) a	我 D	T <sub>A</sub> = 25°C	1.5	1.15	一个
		T <sub>A</sub> = 70°C	1.2	0.92	
脉冲漏电流 b	我 DM	6			
雪崩电流 b	我 AS	6			
单雪崩能量	E AS	1.8		兆焦耳	
连续源电流 (二极管导通) a	我 S	0.6		一个	
功耗 a	P D.	T <sub>A</sub> = 25°C	1.25	0.73	w ^
		T <sub>A</sub> = 70°C	0.80	0.47	
结温和存储温度范围	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	-55至150		°C	

热阻评级					
参数	符号	典型	最大	单元	
最大结到环境热阻 Iat a b i t a	R <sub>thJA</sub>	电视 5秒	80	100	°C/W W
		稳定状态	130	170	
最大的结到脚	R <sub>thJF</sub>	45	55		

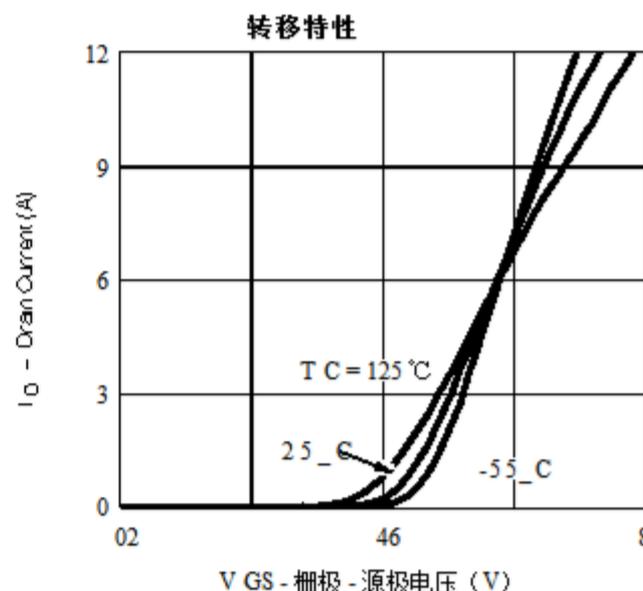
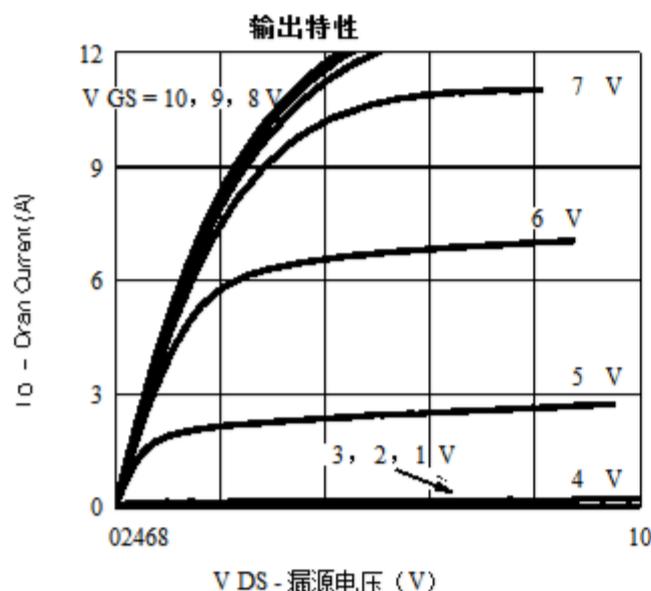
笔记  
一个表面安装在1"x1"FR4板上.  
湾 脉宽受最大结温限制

规格 (T A = 25_C, 除非另有说明)						
参数	符号	测试条件	范围			单元
			敏	典型	马克斯	
<b>静态的</b>						
漏源击穿电压	V ( BR) DSS	V GS = 0V, I D = 1mA	100			V
门限电压	V GS ( th)	V DS = V GS, I D = 250mA	2		4	
门体泄漏	I GS	V DS = 0V, V GS = "20V			"100	nA的
零栅极电压漏极电流	I DSS	V DS = 100V, V GS = 0V			1	嘛
		V DS = 100V, V GS = 0V, T J = 70_C			75	
开态漏电流 a	I D (上)	V DS w 15 V, V GS = 10 V	6			一个
漏源导通电阻 a	R DS (上)	V GS = 10V, I D = 1.5A		0.195	0.250	w ^
正向跨导 a	g fs	V DS = 15V, I D = 1.5A		4		小号
二极管正向电压	V SD	I S = 1.0A, V GS = 0V		0.8	1.2	V
<b>动态 b</b>						
总门电荷	Q g	V DS = 50V, V GS = 10V, I D = 1.5A		3.3	4	NC
门源电荷	Q gs			0.47		
门排水费	Q gd			1.45		
门电阻	R g		0.5		2.4	w ^
<b>交换</b>						
开启延迟时间	t d (on)	V DD = 50V, R L = 33W I D ^ 0.2 A, V GEN = 10 V, R g = 6 W		7	11	NS
上升时间	t r			11	17	
关闭延迟时间	t d (关闭)			9	15	
下降时间	t f			10	15	
源漏排除反向恢复时间	t rr	I F = 1.5A, di / dt = 100A / ms		50	100	NS

## 笔记

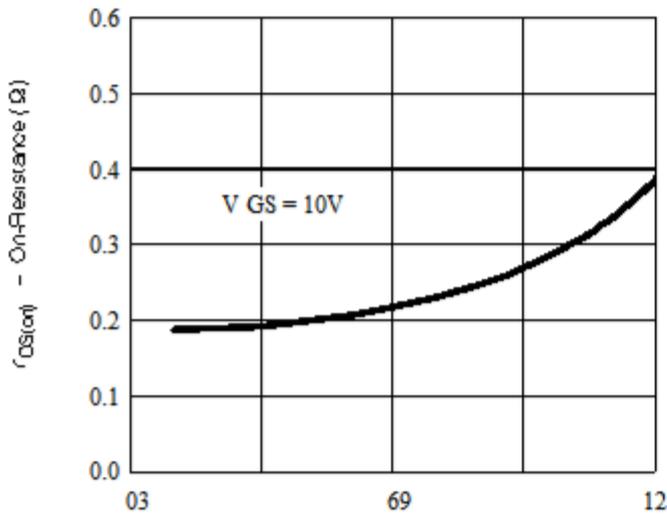
一个脉冲测试: P W v 300 ms 占空比 v 2% .  
 湾 由设计保证, 不受生产测试.

## 典型特征 (25\_C 除非注明)



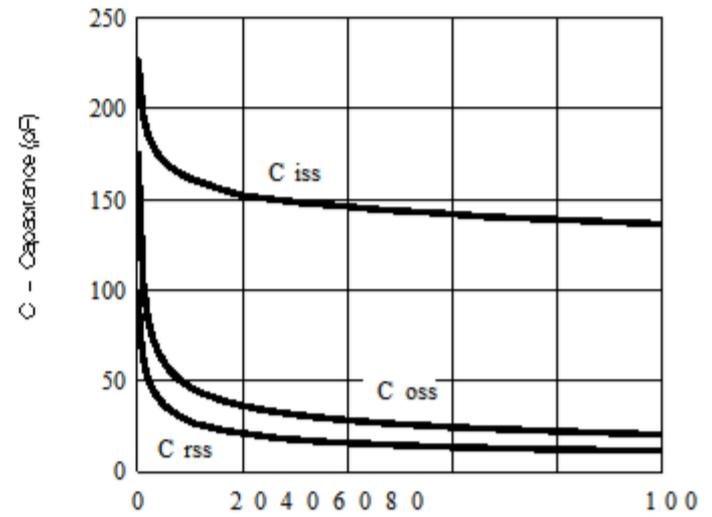
典型特征 (25\_C除非注明)

导通电阻与漏极电流



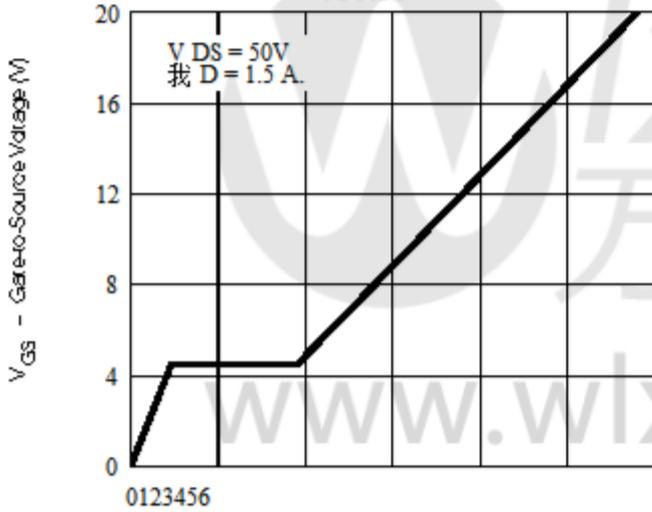
$I_D$  - 漏极电流 (A)

电容



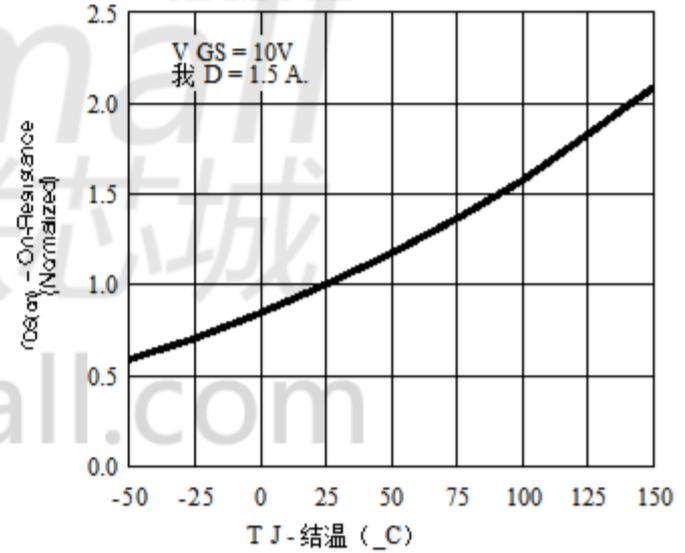
$V_{DS}$  - 漏源电压 (V)

门收费



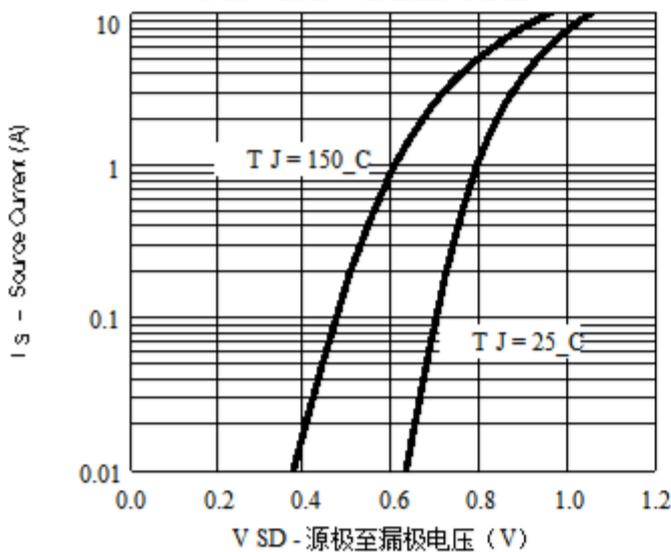
$Q_g$  - 总闸电荷 (nC)

导通电阻与结温



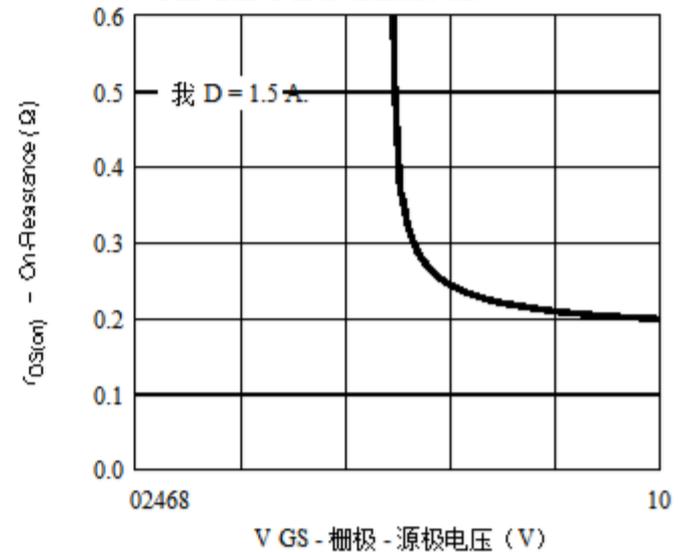
$T_J$  - 结温 ( $^{\circ}C$ )

源极 - 漏极二极管正向电压



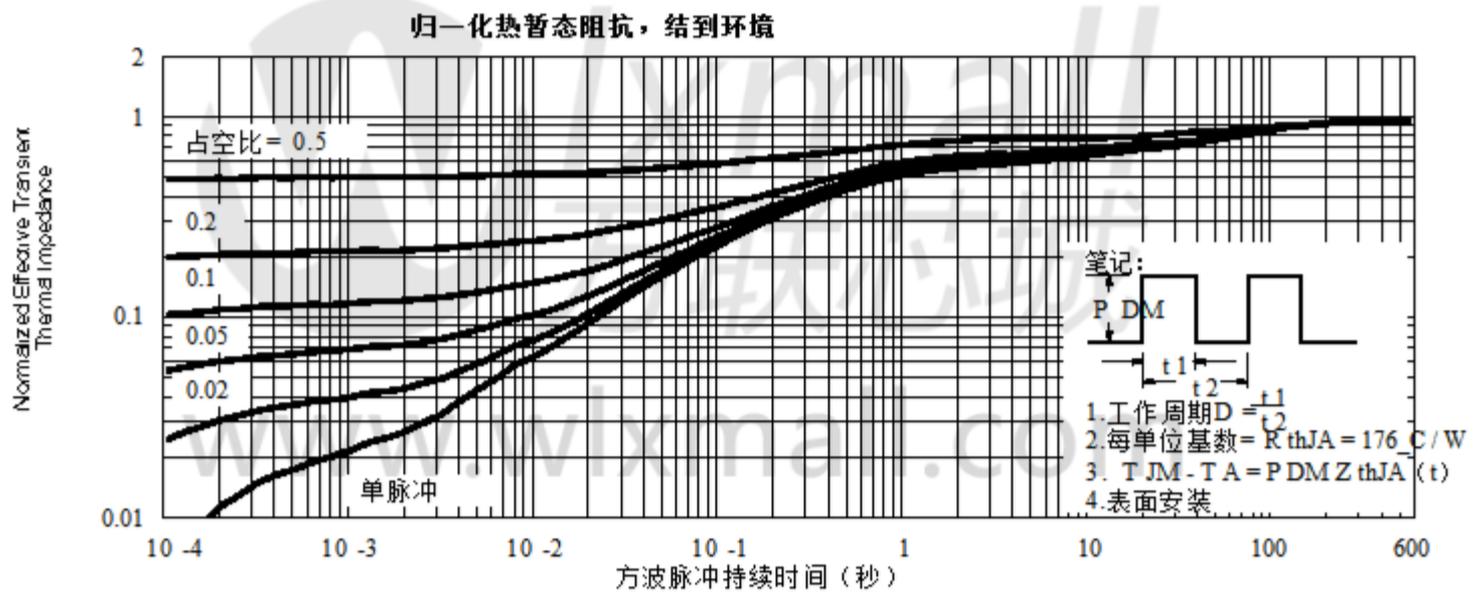
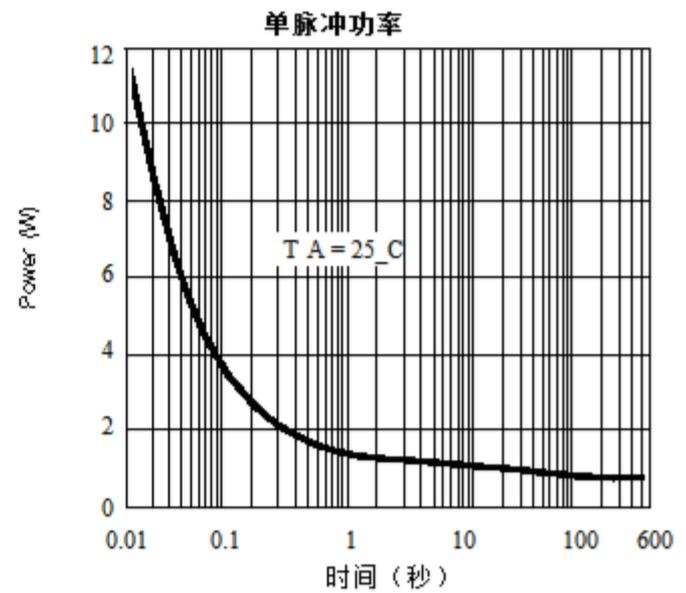
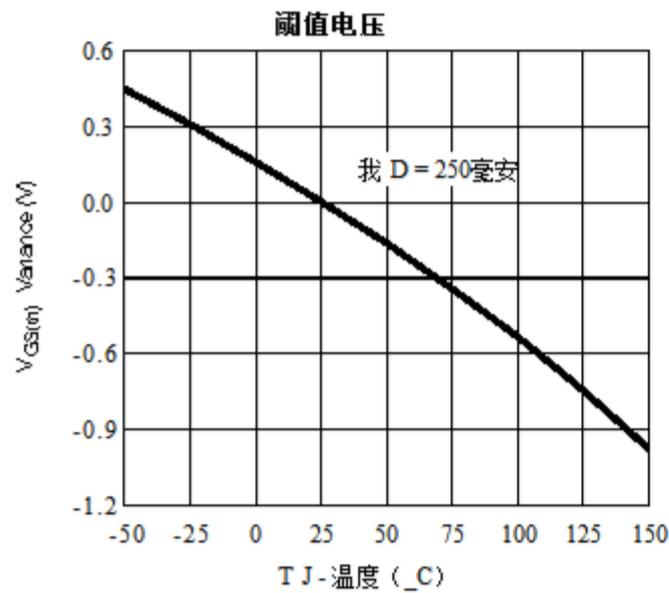
$V_{SD}$  - 源极至漏极电压 (V)

导通电阻与栅源电压的关系



$V_{GS}$  - 栅极 - 源极电压 (V)

典型特征 (25\_C除非注明)





## 放弃

所有产品规格和数据如有更改,恕不另行通知.

Vishay Intertechnology, Inc., 其关联公司, 代理商和员工, 以及代表其所有人员的所有人员 (以下统称“Vishay”) 不承担任何责任, 包括任何错误, 不准确或不完整的内容或与任何产品有关的任何其他公开内容.

Vishay不承担因使用或应用本文所述任何产品或任何产品而引起的任何和所有责任. 本文提供的信息在法律允许的最大范围内. 产品规格不扩展或. 否则请修改Vishay的购买条款和条件, 包括但不限于所表达的保证. 其中, 适用于这些产品.

没有任何许可, 明示或暗示, 以禁止反言或其他方式授予任何知识产权文件或Vishay的任何行为.

此处显示的产品不适用于医疗, 救生或维持生命的应用, 除非. 否则明确表示. 使用或销售Vishay产品的客户没有明确说明用于此类. 应用程序完全由自己承担风险, 并同意全面赔偿Vishay所产生或产生的任何损害. 从这种使用或销售. 请联系授权的Vishay人员获取有关的书面条款和条件. 为此类应用而设计的产品.

本文中提到的产品名称和标记可能是其各自所有者的商标.

